



V2.1

中科海高
HiGaAs Microwave

HGC133-8A

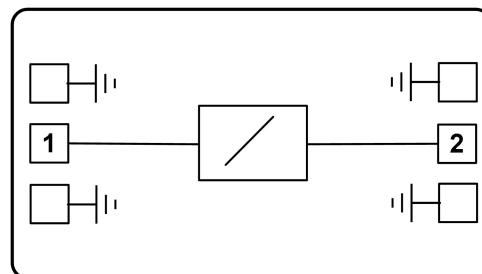
GaAs MMIC
均衡器芯片, 2 - 12 GHz

6

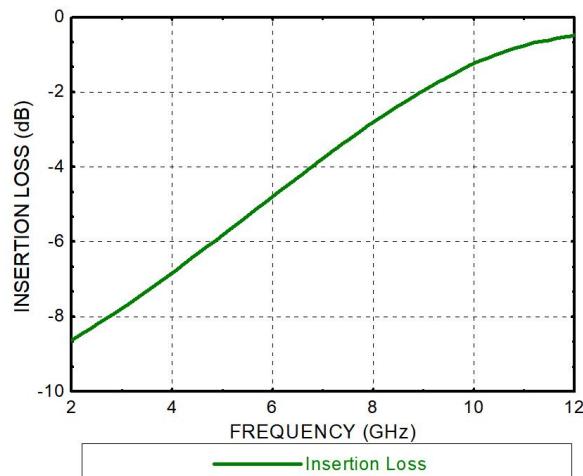
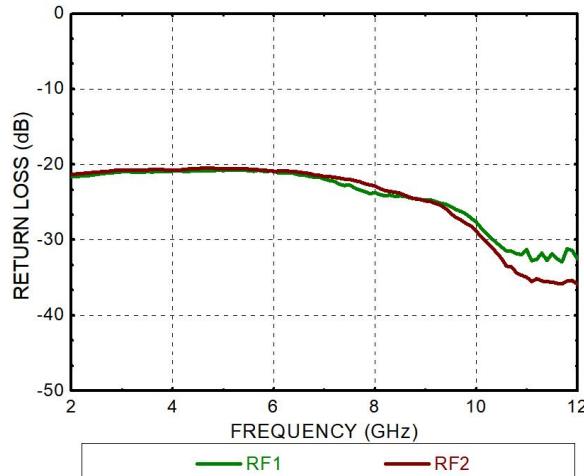
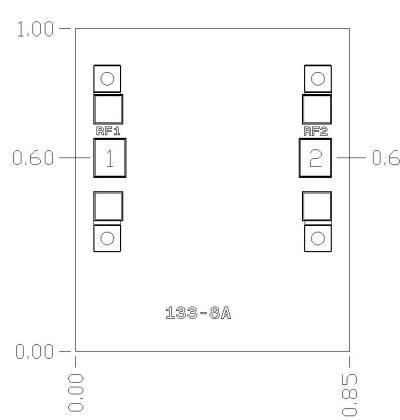
均衡器
|
裸芯

主要特点

频率范围: 2 – 12 GHz
插入损耗: 0.5 dB @ 12 GHz
均衡量: 8 dB
输入输出回波损耗: 20 dB
输入/输出: 50 Ohm 匹配
芯片尺寸: $0.85 \times 1.0 \times 0.1 \text{ mm}^3$

功能框图**性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)**

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	2 - 12			GHz
插入损耗@12GHz		0.5		dB
均衡量		8		dB
回波损耗		20		dB

插入损耗**回波损耗****物理参数****焊盘描述**

焊盘序号	功能	描述
1, 2	RF1, RF2	该焊盘是射频输入/输出端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm, 如果外部射频电压不是 0V, 那么需要外接隔直电容



V2.1

中科海高
HiGaAs Microwave

HGC133-8A

GaAs MMIC
均衡器芯片，2 - 12 GHz

6

均衡器 — 裸芯片

注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100 μm
3. 典型键合焊盘尺寸为 120*100 μm^2
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN+PBO；厚度：
0.5+1.6 μm

极限参数

1. 射频输入功率：+30 dBm
2. 储存温度：-65 ~ +150 °C
3. 工作温度：-55 ~ +85 °C